19 日本国特許庁(JP)

40 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 93649

Mint Cl.

識別記号

广内整理番号

母公開 昭和60年(1985)5月25日

7/12 7/00 G 11 B H 01 S 3/096

7247-5D 7734-5D 7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称。

半導体レーザ光ピックアップのノイズ除去方法

顧 昭58-201593 創特

23出 願 昭58(1983)10月27日

雅 博 79発 明 者 粂 明 健 渚 涏 B の発 砂発 眀 者 清 水 裕 子 尻 眀 者 文 勿発 田 眀 者 伊 藤 雄 砂発 優 眀 者 砂発 和 H

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 門真市大字門真1006番地

松下電器產業株式会社内

松下電器産業株式会社 顔 ⑦出 人

外1名

敏男 30代 理 弁理士 中尾

細 101

1、発明の名称

半点体レーザ光ビックアップのノイズ除去方法

2、特許謝収の範囲

- (1) 半導体レーザからの出射光の一部を第一の光 電変換器子で受け、前記第一の光電変換素子で 変換された電気預号を、ディスク面から反射さ れた前型半導体レーザの反射光が第二の光電変 換数子で光電変換された電気信号に加えること により、ノイズ成分を排殺して、前配反射光の . 慣報信号のS/N比を向上させることを特徴と する半導体レーザ光ピックアップのノイズ除去
- (2) 第一の光電変換若子が半導体レーザの封正管 器の内面の出射光波過用窓の周辺に接着されて いることを特徴とする特許請求の⑩囲第1 項記 叔の平海体レーザ光ビックアップのノイズ除去 **ブブ ジェ**。
- 3、発明の詳細な説明 遊楽上の利用分野

本発明はディジタルオーディオディスク(DAD) や光ディスクファイル等の光筒報処理分野で用い られる単源体レーザ光ピックアップのノイズ除去 方法に関するものである。

従来何の構成とその問題点

近年半減体レーザは、小型・軽量、高効率で高 信頼性のため、DADや光ディスクのピックアッ プ用の光源として確固たる地位を築いている。

この様なピックアップに用いられる半導体レー **ザとしては微小スポットに絞る事が可能で、微モ** ードが単一モードの半導体レーザで、レーザビー ムの非点隔差が数 μ m 以下の性能が要求される。 この様な性能を有する単導体レーザは、レーザグ イオードのP-N接合に水平方向に川折率分布を 持たせ、活性層を光導放路とした構造にすること。 により実現できる。とれは通常刷析率導放型半導 体レーザと呼ばれるが、この顔のレーザでは横モ ードが単一モードになると共に、縦モードも単一 モードとなる。

さてDAD用の光ピックアップを例にとり、そ



の代数的な光学系を第1図に示し、屈折率導数型 半導体レーザを光源に用いた時の問題点について 述べる。

ところが前記川折率将波烈レーザはスペクトル の単一性が良く、そのコヒーレント長が第1図に

ことにより、ノイズ成分を相殺するという構成に なっている。

実施修の説明

以下本発明の一実施例について説明する。

第4 図化本収施例の方法によるノイズ低度の効果を示す。

特開昭60-93649(2)

示す様なピックアップのレーザ1とディスク5間の距離に比べてかなり長いので、レーザへの傷選光が存在すると干渉効果により半導体レーザ光が 人イズが著しく増大する。これは戻り光ノイズが発生すると情報信号の5と N が低下してしまい、ビットエラーを引き起と図に下がある。この様なノイズの一例を第2図にです。これは半導体レーザ1の光出力を一定にしていて、ディテク々6の出力をオンロスコープで観測したものである。

発明の目的

本発明は上記従来の欠点に鑑み、半導体レーザ に戻り光ノイズが発生しても悩報信号中に含まれ るノイズ成分を相殺して S / N の低下を防ぐビッ クアップのノイズ除去方法を提供するものである。 発明の構成

この目的を選成するために本発明の半導体レーザ光ビックアップノイズ除去方法は、半導体レーザ出射光の一部をディテクタで受け、ノイズ信号を取り出し、これを逆相にして情報信号に加える

ことではディスク6の代りに同じ反射率のミラーを置き、半導体レーザ1を一定出力で駆動させ、 差動増幅器9の出力をオンロスコープで観察した。 ディテクタ7の出力との於動を行わない時の信号 出力が第4図のな側の被形で、2%に及ぶ振幅の ノイズが存在しているが、整動増幅を行いノイズ を相殺させるとノイズ振幅は O・1 %以下となり、 26 dB & S / N が向上している。

次に本発明の他の実施例について、図面を参照 しながら説明する。

第 6 図は、本発明の他の実施例における半導体レーザ光ピックアップノイズ除去方法を示す図である。第 5 図において、アは半導体レーザ素子の封止容器 1 2 の天面の窓 1 3 の周辺に投着されたディテクタであって、出射レーザ光の強度を検知して、その出力が A P C 回路 1 1 に入力され、半導体レーザ素子への供給電力を A P C (Automatic Power Control) するために用いられるととしに、ディスク 5 から反射されて情報を含んだレーザ光がビームスブリッタ 2 で反射されて人射した

特別昭60-93649(3)

ディテクタ 6 の出力とともに、差勤増幅路 9 に人力され、ここで前述の一実施例と同様に、ノイズ 成分が相数される。

以上のように、本契施例によれば、ディテクタ 7は、APC動作のためのディテクタを兼ねてい るので、簡単な構成でノイズを除去することがで きる。

発明の効果

以上の様に本発明の方法は光ピックアップにおいて、半導体レーザ光の一部を光電変換してノイス信号を得、これと情報信号の差動増福を行うことにより、戻り光ノイズを大幅に相殺することが出来、その実用的効果は大なるものがある。

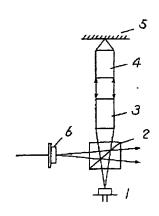
4、図面の簡単な説明

第1 図は従来の半導体レーザ光ビックアップの 動作を示す図、第2図は第1 図のビックアップ系 を用いたときの出力信号被形を示す図、第3図は 本発明の一実施例における半導体レーザ光ビック アップのノイズ除去方法を示す図、第4図は第3 図のビックアップ等を用いたときの出力信号被形 を示す図、第5図は本発明の他の実施例における 半導体レーザ光ビックアップのノイズ除去方法を 示す図である。

1 …… 半導体レーザ、2 …… ビームスブリッタ、3 …… コリメートレンス、4 …… 対物レンズ、5 …… ディスク、8 …… ディテクタ、7 …… ディテクタ、8 …… 電顔、9 …… 差勤 増幅器、10 …… 増幅器、11 …… 本P0 削略、12 …… 容器、13 …… 天面の窓。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 だか1名

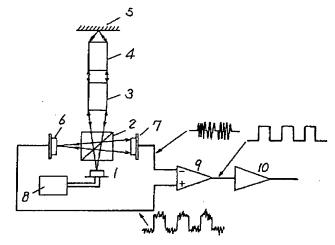
第1図



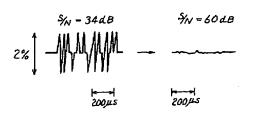
第2日

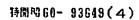


第 3 図



氯 4 图







第 5 图

